

ENSAYO DE MOSFET DE POTENCIA PARA LA REGULACIÓN EN MICRO CENTRALES ELÉCTRICAS

Claudio D. Kruberto ¹, Germán H. Pereta ², Marcos R. Rozicki ³, Víctor H. Kurtz ^{4(*)}

Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ing. Electrónica. Dpto. de Electrónica. Cátedra: Dispositivos electrónicos. Práctica estudiantil supervisada. Proyecto de investigación.

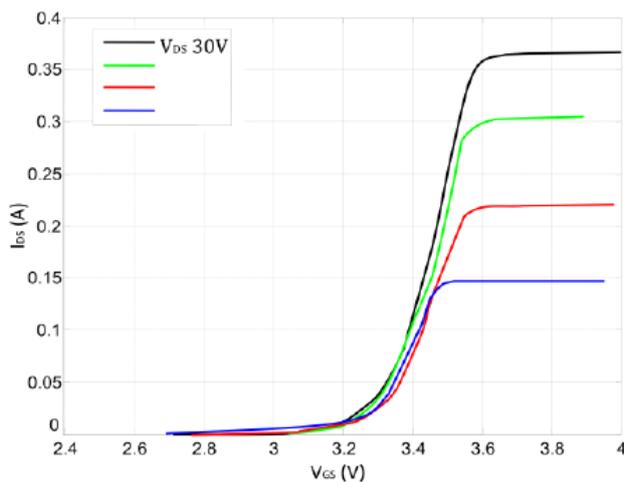
¹claudiokruberto@yahoo.com ²german_gena@hotmail.com ³rozickimarcos@yahoo.com.ar

Modalidad: Poster Tutor: Mgter. Ing. Kurtz Victor Hugo; ⁴kurtzvh@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados y conclusiones del ensayo de un MOSFET de potencia (*Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor* - Transistor Semiconductor de Oxido Metálico por Efecto de Campo), de enriquecimiento canal "n".

El mismo está orientado a difundir las características de este dispositivo, usado generalmente en operaciones de control de potencia (como es el caso en Micro Centrales Eléctricas), con la técnica conocida como conmutación (Switching).



PALABRAS CLAVE: MOSFET de potencia. Micro Generación. Control. Técnica de conmutación. Didáctica

(*) Y el plantel docente de la asignatura Dispositivos Electrónicos: **Jorge A. Olsson, Germán A. Xander y Luis A. Mund.**